論文の内容の要旨

論文題目:フラストレートした反強磁性体における非共面スピン構造による磁気・輸送特性 (Magnetic and transport properties due to non-coplanar spin structure in frustrated antiferromagnets)

氏 名:肥後 友也

1. 背景

幾何学的フラストレーションを有する 磁性体では基底状態が縮退することに より、スピン液体等の新奇な物理現象 やハイゼンベルク型ハミルトニアン $-J\sum_{\langle i,j \rangle} S_i \cdot S_j$ では説明できない非 共線・非共面スピン構造の発現が期待



図1 (a)3Qスピン構造. (b)AIAOスピン構造.

され、精力的に研究が行われてきた。非共線・非共面スピン構造ではベクトルスピンカイラリティ $\kappa_{ij} \sim S_i \times S_j$ やスカラースピンカイラリティ $\chi_{ijk} \sim S_i \cdot (S_j \times S_k)$ といった複数のスピンによって構成さ れる高次の自由度が有限となることが期待され、実際、電気磁気効果[1]やトポロジカルホール輸送現 象[2]、カイラルスピン液体状態[3]などの振る舞いがフラストレート格子を有する磁性体で観測されて いる。上記の振る舞いは主に強磁性相関が主要な系において観測されてきたが、近年、5d 遷移金属 パイロクロア酸化物 Eu₂Ir₂O₇[4-6]や Nd₂Ir₂O₇[7]、Cd₂Os₂O₇[8]において、頂点共有する正四面体上で 実現する All-in/All-out (AIAO) 反強磁性秩序状態(図 1(b))が観測され、反強磁性体で実現する非 共面スピン構造が注目を集めている。

AIAO 反強磁性秩序状態では(111)面単層のみを考えると、X_{ijk}が有限となり、上述のようなエキゾ チックな振る舞いが発現する可能性が有る。さらに、巨視的な八極子秩序とも考えられる特徴的なス ピン構造故に、磁化はゼロとなることが期待される一方で時間反転操作で交換できる2種のドメインが 存在し、強磁性の場合と同様に多磁区状態となることが報告されている[9,10]。また、スピン軌道相互 作用の強い Ir 系においては、トポロジカルに非自明な基底状態が実現する可能性が複数の理論計 算によって示唆され [11-13]、実験においても Nd₂Ir₂O₇ で異常なドメイン間磁気伝導[14]が、Eu₂Ir₂O₇ では起源不明な磁気モーメントの出現[4]が観測されており、その反強磁性磁気ドメインの詳細な機構 解明が求められているが、モデル物質が少なく体系的な理解が進められていなかった。

そこで我々は新たなモデル物質となりうるパイライト構造を有する 3d 遷移金属反強磁性体 NiS₂[15-17]と MnTe₂[18-20]に着目し研究を行った。NiS₂ (MnTe₂)は S = 1 (5/2)の磁性イオン Ni²⁺ (Mn²⁺)がフラストレート格子である面心立方格子上に配列しており、30 K < $T \leq 38$ K ($T \leq 87$ K)に おいて図 1(a)に示した 3Q スピン構造が実現する。3Q 構造は辺共有した四面体上で実現する AIAO 構造と考えることが出来、AIAO 構造と同様に巨視的な八極子秩序状態である為に、磁化がゼロの反 強磁秩序であるにもかかわらず時間反転対称性が破れた状態が期待されるスピン構造である。

2. 目的·手段

系が磁化を持たない反強磁性秩序であるにも関わらず、時間反転対称性を破る 3Q 構造を有する NiS₂とMnTe₂の純良単結晶試料を用いて磁化や輸送特性測定等を行うことで、反強磁性非共面スピ ン構造固有の磁性や輸送特性を明らかにする。

3. 結果·考察

<u>3-1. NiS2の磁性</u>:

NiS₂では 3Q 構造が 30 K < T $\leq T_{N1} = 38$ K で現れ、 $T \leq T_{N2}$ = 30 K では 3Q 構造が[100]へ微 小にキャントし弱強磁性(WF)が現 れる事が報告されている[17,21]。 図 2 に NiS₂単結晶の 0.1 T 下で の帯磁率 $\chi(T) = M(T)/H c = 5$ 。



先行研究と同様、 T_{NI} =38 Kと T_{N2} =30 Kに3Q相とWF相に対応する異常が観測されている。図 3-inset に示した $\chi(T)$ の測定から、3Q相において微小な強磁性モーメントの存在を示唆するヒステリシ スが観測された。このヒステリシスは中性子散乱[22]や比熱測定[15]から磁気長距離秩序形成による ものだとわかっている。また、AIAO構造を有する $Eu_2Ir_2O_7[4]$ で観測されたヒステリシスと同様に、磁場 方向に依存しない等方的な振る舞いを見せており、反強磁性非共面スピン構造由来の性質である可 能性も考えられる。その起源を明らかにする為に、3Qドメインの磁場制御を試みた。

3-2. NiS2の 3Q 相で生じる強磁性の起源解明と3Q 構造ドメインの磁場制御の試み:

3Q 構造では系全体の磁化がゼロとなることが期待される。AIAO 構造を有する系で理論的に示唆 されているのと同様に 3Q 構造からなるドメイン(3Qドメイン)の磁壁に強磁性モーメントが生じている可 能性を考えた場合[23]、単一な 3Qドメインが実現した際には、試料中に磁壁が存在しない為、強磁 性が現れないことが予想される。上記の仮定を検証する為に磁化を有さない 3Qドメインを WF 相での WFドメインの磁場制御により間接的に制御することを試みた。その手順を以下に示す。 (1)磁場中冷却(FC)磁場 $\mu_0 H_{FC} = -0.1 \sim 5 T$ において磁場中冷却を 2 K(WF 相)まで行う[FC2K プロセ ス]と 31 K(3Q 相)まで行う[FC31K プロセス]という 2 種類の条件で試料を冷却する

(2)最低温度(2K もしくは 31K)で 0.1T に磁場を変え、昇温過程にて帯磁率 (T)を測定する

先行研究のスピントルク測定よりWFドメインはH//[100] <~2T でのFC で単一ドメインとなることが 報告されている為[24]、H//[100]へ印加した。また、3Q 相での微小な強磁性モーメントの変化を体系 的に理解する為に、 T_{NI} 直上の常磁性相の温度 39 K からの帯磁率(磁化)の変化量 $\Delta \chi(T) = (\chi(T) - \chi(39K))/\chi(39K) \times 100\%$ をその指標として用いた。図 3 (a)に[FC2K プロセス]後(WFドメインによる 3Q ドメインの間接的な制御を行なった場合)に測定した NiS₂単結晶の $\Delta \chi$ の温度依存性を示す。-0.1 T $\leq \mu_0 H_{FC} \leq 0.1$ T では H_{FC} の増加に比例して $\Delta \chi$ が増加しているものの、 $\mu_0 H_{FC} > 0.1$ T では $\Delta \chi$ が 減少し、WFドメインが単一であると予想される $\mu_0 H_{FC} = 3$ T と5 T では ZFC(0 T)の場合とほぼ同様の振



舞いを見せるという異常な H_{FC} 依存性が見られた。磁性不純物やスピンキャント、スピングラスが起源 である場合には $\Delta \chi$ は H_{FC} の増加に伴って単調増加することが期待されるが、上で予測した 3Qドメイ ンの磁壁を考えると異常な H_{FC} 依存性を説明することが出来る。また、図 3(b)に示した[FC31K プロセ ス]後(WFドメインによる 3Qドメインの間接的な磁場制御を行わなかった場合)の $\Delta \chi$ は、 H_{FC} の増加に 伴い単調増加しており、これは多磁区状態で磁壁のモーメントのみが配向する場合を考えると理解す ることが出来る。以上の測定より、帯磁率というマクロな物理量からの推察ではあるものの、WF 相へ磁 場中冷却を行うことによる WFドメインの単一化に対応し間接的に 3Qドメインが単一化されていくこと を示唆する結果が得られた。また、その H_{FC} 依存性(図 3(c))は 3Q 相で生じる強磁性成分の起源を 3Q 構造が作る磁壁と考えた場合によく説明することが出来る。

<u>3-3. MnTe2の 3Q</u>相における異方的圧力による 3Q構造ドメインの磁場制御の試み:

MnTe₂では 3Q 構造が $T \leq T_N \sim 87$ K とNiS₂に比べて高温から発現することが先行研究によって 明らかにされている[20]。まず、3Q 相に NiS₂同様に強磁性モーメントが現れるか確認する為に T >> T_N から FC 冷却磁場 $\mu_0 H_{FC} = -0.1 \sim 5$ T で 5 K まで FC した([FC5K プロセス]とする)後、磁場を 0.1 T に変更し、昇温過程において MnTe₂単結晶の帯磁率 $\chi(T)$ を測定した。その結果、図 4(a)に示す様に H_{FC} の増加に伴って χ が単調増加する振る舞い(NiS₂ の多磁区状態と類似)が確認できた。上述の NiS₂の実験から、その 3Q ドメインは 5 T 程度の外部磁場では制御が難しく、WF ドメイン等の磁化を 有するドメインによる制御が必要という結果が得られたが、MnTe₂では WF 相が現れない為、3Q ドメイ ンの磁場制御は難しい。そこで、系に異方的圧力を印加し 3Q 構造自体に自発磁化を誘起し、磁場に よってその自発磁化が誘起された 3Q ドメインを制御/単一化することを試みた。MnTe₂の磁気構造から 予測される磁化誘起が可能な圧力方向:[111]に 0.1 kbar 程度の圧力を印加したところ、 $10^3 \mu_B$ オー ダーの磁化を誘起することに成功した。さらに、誘起された自発磁化が $\mu_0 H_{FC} = \pm 5$ Oe という微小な 磁場での FC で上凸(+5 Oe)と下凸(-5 Oe)に分かれ、磁場を正方向に大きくした場合は上凸(+5 Oe)に、 磁場を負方向に大きくした場合には下凸(-5 Oe)に一致する振る舞いが見られた。この振る舞いは、自 発磁化が誘起された 3Q ドメインが FC により、単一方向に揃ったことを支持する。



図4 MnTe₂の (a)[FC5Kプロセス]後に 測定した χ (*T*). (b) 圧力*P* // [111] ~ 0.1 kbar下で[FC5Kプロセス] 後に測定した χ (*T*). いずれの測定も H_{FC} // [111], μ_0H // [111] = 0.1 T で行った.

4. まとめ・展望

特徴的な非共面スピン構造を有する反強磁性体の物性を明らかにするために、3Q構造(辺共有型 AIAO構造)を有するパイライト型反強磁性体を用いて磁気・輸送特性測定を行った。NiS2では、低温 相に存在するWFドメインをFCにより制御することで、通常磁場制御できない磁化ゼロの反強磁性ド メイン(3Qドメイン)の間接的な磁場制御に成功した。また、3Q相で現れた強磁性モーメントの起源が 3Q-磁壁であることを示唆する実験結果を得た。MnTe2においても多磁区状態のNiS2と類似のχ(T)の 振舞いを観測し、さらに、3Q構造に異方的圧力を印加し自発磁化を誘起することで、その自発磁化 の向きが微小な磁場のFCによって揃えられることを明らかにした。特徴的な反強磁性非共面スピン構 造で期待される非対称非線形磁化やスカラースピンカイラリティに関係した振る舞いは、単一ドメイン にすることでより顕著に現れる事が期待され、今回我々が得た結果は非共面スピン構造を有する反強 磁性体を研究する上で重要な指針になると考える。

一方で、今後ドメインの直接観測を行いそのドメインの詳細なダイナミクスを明らかにする必要がある。特徴的な反強磁性非共面スピン構造に由来するその他の物性の探索も今後の課題である。

5. 参考文献

- [1] Y. Tokura, et al., Rep. Prog. Phys. <u>77</u>, 076501 (2014).
- [2] Y. Taguchi, et al., Science 291, 2573 (2001).
- [3] Y. Machida, et al., Nature <u>463</u>, 210 (2010).
- [4] J. J. Ishikawa, et al., Phys. Rev. B 85, 245109 (2012).
- [5] S. Zhao, et al., Phys. Rev. B <u>83</u>, 180402 (2011).
- [6] H. Sagayama, et al., Phys. Rev. B 87, 100403 (2013).
- [7] K. Tomiyasu et al., J. Phys. Soc. Jpn. <u>81</u>, 034709 (2012).
- [8] J. Yamaura, et al., Phys. Rev. Lett. <u>108</u>, 247205 (2012).
- [9] T.-h. Arima, J. Phys. Soc. Jpn. <u>82</u>, 013705 (2013).
- [10] S. Tadif et al., arxiv : 1407.5401.
- [11] D. Pesin, et al., Nature Phys. <u>6</u>, 376 (2010).
- [12] B.-J. Yang, et al., Phys. Rev. B <u>82</u>, 085111 (2010).

- [13] X. Wan, et al., Phys. Rev. B <u>83</u>, 205101 (2011).
- [14] K. Ueda, et al., Phys. Rev. B 89, 075127 (2014).
- [15] N. Matsuura et al., Phys. Rev. B <u>68</u>, 094409 (2003).
- [16] K. Kikuchi, et al., J. Phys. Soc. Jpn. <u>44</u>, 410 (1978).
- [17] K. Kikuchi, et al., J. Phys. Soc. Jpn. <u>45</u>, 444 (1978).
- [18] J. M. Hastings, et al., Phys. Rev. <u>115</u>, 13 (1959).
- [19] M. S. Lin, et al., Sol. Stat. Comm. 6, 687 (1968).
- [20] P. Burlet, et al., Phys, Rev, B 56, 14013 (1997).
- [21] T. Thio, et al., Phys. Rev. B 52, 3555 (1995).
- [22] K. Kikuchi, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 47, 484 (1979).
- [23] Y. Yamaji et al., Phys. Rev. X 4, 021035 (2014).
- [24] H. Nagata, et al., Jpn. J. Appl. Phys. <u>15</u>, 1507 (1976).